



## **BF965: Mosfet N-Ch Dual Gate Field Effect Tetrode Depletion mode**



# Descripción

**Nombre:** MOSFET N-CH DUAL GATE FIELD EFFECT TETRODE DEPLETION MODE Tetrodo de efecto de campo MOS de doble puerta de canal N, modo de agotamiento **Referencia:** BF965

- **Tipo de transistor:** MOSFET
- **Tipo de canal de control:** canal N
- **Disipación máxima de potencia:** 0,2 W
- **Voltaje máximo drenaje-fuente |Vds|:** 20 V
- **Voltaje máximo puerta-fuente |Vgs|:** 8,5 V
- **Corriente máxima de drenaje |Id|:** 0,03 A
- **Temperatura máxima de unión Tj:** 150 °C
- **Capacitancia de salida:** 1 pF
- **Resistencia máxima en estado activo de la fuente de drenaje Rds:** 200 ohmios

**Marca:** VISHAY SEMICONDUCTORS **Empaque:** SOT-13 **Precio por:** Unidad **Ficha Técnica:** [BF965 \(Siemens\)](#)

## Información del producto

**Descripción:** MOSFET N-CH DUAL GATE FIELD EFFECT TETRODE DEPLETION MODE VISHAY SEMICONDUCTORS Referencia: BF965 El BF965 es un transistor MOSFET de canal N de doble puerta. Esto significa que tiene dos compuertas que permiten un control más preciso sobre la corriente que fluye a través del dispositivo. Esta característica lo hace especialmente útil en aplicaciones de alta frecuencia, como amplificadores de radiofrecuencia (RF).

**Precio:** \$84.306 IVA INCLUIDO

**SKU:** 9-11-5

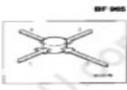
**Categorías:** [RF TRANSISTORES Y MOSFETS](#), [SEMICONDUCTORES](#)

**Etiquetas:** [0090011000005](#), [9-11-5](#), [BF965](#), [datasheet](#), [MOSFET N-CH DUAL GATE FIELD EFFECT TETRODE DEPLETION MODE](#), [pinout](#), [RF TRANSISTORES Y MOSFETS](#), [SEMICONDUCTORES](#), [SMD](#), [VISHAY SEMICONDUCTORS](#)

**SIEMENS**

Silicon N-Channel MOSFET Tetrode

- Integrated complementary electrolytic gate structure (IG) technology
- For VHF applications, especially in TV sets and communication systems, R.F. CATV tubes



Type	Marking	Ordering Code	Pin	Symbol	Package
BF 965		CA1000-F100	1	1	13-pin

Parameter	Symbol	Values	Unit
Drain-source voltage	V <sub>DS</sub>	20	V
Drain current	I <sub>D</sub>	30	mA
Gate-source voltage (maximum)	V <sub>GS</sub>	8.5	V
Gate-source capacitance (1 kHz, 0 V)	C <sub>gs</sub>	200	pF
Drainage temperature range	T <sub>j</sub>	-55...+150	°C
Channel resistance	r <sub>ch</sub>	150	Ω
Thermal resistance	R <sub>th(j-c)</sub>	1	°C/W

■ A235L02 006L853 116 ■